







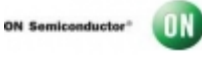

	<h2 style="color: red;">NVD4809NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD4809NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NVD4809NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD4809NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 58A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9.6A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1456pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVD4809NT4G ist neu im Original, Suche NVD4809NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD4809NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD4809NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NVD4806NT4G O NVD4806NT4G O	 NVD4810NT4G VB NVD4810NT4G VB	 NVD4808NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 63A DPAK	 NVD4809NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A DPAK
 NVD4805NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 88A DPAK	 NVD4815NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK-4	 NVD4810NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A DPAK	 NVD4806NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 76A DPAK

heiße Teile

Mehr

NVD14N03RT4G	NVD2014A	NVD20N03L27T4G	NVD2955T4G	NVD3055-094T4G
NVD3055L170T4G	NVD4804NT4G	NVD4805NT4G	NVD4806NT4G	NVD4808NT4G
NVD4809NHT4G	NVD4810NT4G	NVD4813NHT4G	NVD4815NT4G	NVD5117PL
NVD5117PLT4G	NVD5413NT4G	NVD5414NT4G	NVD5484NLT4G	NVD5490NL
NVD5490NLT4G	NVD5802NT4G	NVD5802NT4G	NVD5803N	NVD5803NT4G
NVD5805NT4G	NVD5806N	NVD5806NT4G	NVD5806NT4G	NVD5807NT4G
NVD5809NT4G	NVD5862NLT4G	NVD5862NT4G	NVD5863NL	NVD5863NLT4G
NVD5863NT4G	NVD5865NL	NVD5865NLT4G	NVD5867NL	NVD5867NLT4G
NVD5867NLT4G	NVD5890NLT4G	NVD5894NLT4G	NVD6414ANT4G	NVD6415ANLT4G
NVD6415ANT4G	NVD6416ANLT4G	NVD6416ANT4G	NVD6495NL	NVD6820NLT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited